# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-299731

(43) Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.CI.

H01S 3/06

H01S 3/0933 H01S 3/10

(21)Application number: 2001-104942

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

03.04.2001 (72)Inventor: SHIMIZU MAKOTO

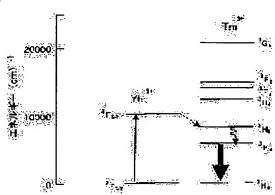
KANAMORI TERUHISA

**MORI ATSUSHI** 

(54) AMPLIFIER FOR OPTICAL FIBER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To operate an amplifier for optical fiber at high efficiency by using a wavelength of excitation light capable of disregarding absorption between the excitation levels of Tm(thulium) ion. SOLUTION: First, Yb(ytterbium) is first excited by a system co-added with the Yb, rather than directly exciting the Tm ions, and then due to the energy transfer between Yb and Tm ions of 3H3 level of Tm are excited, and a population inversion between 3F4 and 3H6 levels is formed through no-radiative process.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

01.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-299731 (P2002-299731A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> H 0 1 S 3/06 3/0933 3/10 | 歲別紀号 | F I<br>H 0 1 S | 3/06<br>3/10<br>3/091 | 7-73-ド(参考)<br>B 5 F 0 7 2<br>Z<br>S |
|--|------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
|  |      |                | 0,001                 | 3                                   |

# 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

|          |                             |            | The state of the s |
|----------|-----------------------------|------------|--|
| (21)出顧番号 | 特顧2001-104942(P2001-104942) | (71) 出顧人   | 000004226  |
|          |                             |            | 日本電信電話株式会社   |
| (22)出顧日  | 平成13年4月3日(2001.4.3)         |            | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号  |
|          |                             | (72)発明者    |  |
|          |                             |            | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日  |
|          |                             |            | 本電信電話株式会社内   |
|          | İ                           | (72)発明者    |  |
|          |                             | (10/)09/14 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日  |
|          |                             |            |  |
|          |                             |            | 本電信電話株式会社内   |
|          |                             | (74)代理人    | 100077481  |
|          |                             |            | 弁理士 谷 義一 (外1名)   |
|          |                             |            |  |
|          |                             |            |  |
|          | i                           |            |  |

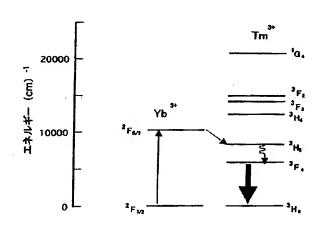
#### 最終頁に続く

# (54)【発明の名称】 光ファイバ増幅器

#### (57)【要約】

【課題】 Tm(ツリウム)イオンの励起準位間吸収を無視し得る励起光の波長を使用し、光ファイバ増幅器の高効率化を図る。

【解決手段】  $Tm / 4 \sim a$  直接励起するのではなく、最初に、Yb ( $4 \sim c$  + c



٦

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 増幅媒体である光ファイバにおける励起 光の誘導放出現象により信号光を増幅する光ファイバ増 幅器において、

前記光ファイバのコア部分にTmとYbを共添加したと とを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項2】 増幅媒体である光ファイバにおける励起 光の誘導放出現象により信号光を増幅する光ファイバ増 幅器において、

前記光ファイバのコア部分にTmとYbを共添加し、前 10 記光ファイバのクラッド部分にTb、Ho、Eu、D y、SmまたはNdのうちの少なくとも1つを添加した ことを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項3】 前記励起光の波長は、0.85μm以上 0. 98μm以下であることを特徴とする請求項1また は2 に記載の光ファイバ増幅器。

【請求項4】 前記信号光の波長は、1.6μm以上 2. 0μm以下であることを特徴とする請求項1または 3 に記載の光ファイバ増幅器。

【請求項5】 前記信号光の波長は、1.6 μm以上 1. 7μm以下であることを特徴とする請求項2または 3 に記載の光ファイバ増幅器。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ファイバ増幅器 に関し、より詳細には、光ファイバを伝送媒体とする光 伝送システムにおいて、1.6μmから1.9μmに増 幅波長帯域を有する光ファイバ増幅器に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、希土類を添加した光ファイバを増 幅媒体とし、この光ファイバに供給された励起光のエネ ルギーにより引き起とされた誘導放出現象によって、信 号光を増幅する光ファイバ増幅器が知られている。特 に、1. 6 μmから1. 9 μmを増幅帯域とする希土類 添加光ファイバ増幅器として、Tm(ツリウム)を活性 イオンとして用いたTm添加光ファイバ増幅器(TDF A:Tm-doped fiber amplifier) が知られている。 【0003】図1に、Tmイオンのエネルギー準位を示 す。 Tmイオンのエネルギー準位の標記 (例えば <sup>8</sup> H。)法については、T.Sakamoto et al., Proc.QAA' 96, pp.40-43, Monterey California, 1996 に記載され た、いわゆる阪本による標記法を用いた。Tmイオンの エネルギー準位の標記法としては、他に、Weberらによ る方式もあり統一されていない。以下、M.J.Weber et a 1., "Handbook of Laser Science and Technology" Vo 1.1, pp.44-45, CRC Press, New York, 1982 に記載さ れた Weberらによる標記法に従う場合には、各準位の呼

【0004】1.6~1.9µmで増幅を行う場合に

び名を読み替えて対応する必要がある。

分布を実現し、誘導放出過程により増幅動作を行うこと になる。この場合、特に光通信で有用な1.65 µm帯 で利得を得るためには、SFL準位内のシュタルク分裂 したサブレベルの高エネルギー側を増幅の始準位とする ために、<sup>3</sup> H。と<sup>3</sup> F。間に、かなり強い反転状態を実 現する必要がある。従って、励起方法としては、『F。 準位への直接励起の適用は困難であり、より高い励起準 位への光励起を行う必要があった。

2

【0005】とのような必要性から、既に、励起波長 1. 2 μ m において、 H h から H h への励起方法 が、T.Sakamoto et al., Proc.OAA'96, pp.40-43, Mont erey California, 1996 に記載されている。

【0006】図2に、Tmイオンの吸収及び蛍光スペク トルを示す。 F 、 から B H 。 への蛍光のピークが 1. 85 µm前後にあるために、1.65 µm近傍で増幅を 行う場合には、1.65μmより長波長域での増幅され た自然放出光(以下、ASE光という。)が、増幅用フ ァイバを伝搬する際に増幅される現象を、有効に抑圧す る必要がある。もし、ASE光の成長を抑圧しない場合 には、励起光のエネルギーがASE光の発生と増幅とに より消費され、1.65 µmでの増幅に寄与しないとい う問題がある。

【0007】ASE光を抑圧する目的で、例えば、1. 7μmより長波長域でのファイバの損失を高くして、と の波長域でのASE光成分を吸収させることにより、実 効的にASE光の成長を抑える手法が、T.Sakamoto et al., Proc.O4A'96, pp.40-43, Monterey California, 1 996 に記載されている。

【0008】図3に、従来の1.65μm帯で増幅動作 する光ファイバ増幅器の利得特性を示す。図3におい て、点線は、Tmを2000ppmの割合でコアに均一 に添加したZr系フッ化物ファイバを増幅媒体に使用 し、1.2μmの励起光で励起した場合の、1.65μ mの信号光の利得を評価した結果である。実線は、Tm を2000ppmの割合でコアに均一に添加し、Th (テルビウム)を4000ppmの割合でクラッドに均 一に添加したZr系フッ化物ファイバを増幅媒体に使用 し、 $1.2 \mu m$ の励起光で励起した場合の、 $1.65 \mu$ mの信号光の利得を評価した結果である。信号光の入射 レベルは、-40dBmであり、増幅用ファイバのホス トガラス組成と、カットオフ波長と、コアクラッド間の 比屈折率差とは、両者とも同じ値である。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】図3に示したように、 1. 2μm帯を励起光の波長とすることにより、1. 6 5μm帯で利得が得られること、及び1.65μm帯で 効率的な増幅動作を得るためには、クラッドへのTbの 添加が必要である。しかしながら、80mWの励起光量 における出力は、入力-40dBmに対して-20dB は、基底準位(<sup>8</sup> H。)と励起準位(<sup>8</sup> F。)間で反転 50 m以下と低く、励起光から信号光へのエネルギー変換効 (3)

3

率も最大でも10%以下と低く、実用的な特性は実現で きなかった。

【0010】図4に、従来の光ファイバ増幅器における 励起準位間吸収を示す。例えば、1.2 µm帯での励起 光を用いた場合について説明する。1.2μm帯で励起 した場合、<sup>8</sup> H。に励起されたイオンは、無輻射過程に より<sup>®</sup> F <sub>4</sub> に緩和する。<sup>®</sup> F <sub>4</sub> - <sup>®</sup> F <sub>9</sub> 間のエネルギー 差は、波長に換算すると約1.2μmである。また、8 F, 準位に次いで寿命が長い励起準位である。H, から 「G へのエネルギー差も、波長換算にすると約1.2 10 μmである。 このために、図4に示したように、1.2 μm帯で励起した場合には、複数の励起光による励起準 位間吸収(以下、励起光ESAという。)のために、励 起光エネルギーが散逸され、<sup>8</sup> F 4 - <sup>8</sup> H。間の反転分 布形成及び誘導放出に有効利用されていないという問題 があった。

【0011】TDFAの励起波長としては、 H A ある いは。Fュを励起するような方式も考えられるが、この 場合でも励起光ESAが存在するために、励起光エネル ギーの散逸が生じるので、効率的な増幅動作が実現でき ないという問題もあった。

【0012】本発明は、このような問題に鑑みてなされ たもので、その目的とするところは、『F』-『H。間 の反転分布形成により増幅動作するTDFAにおいて、 励起光ESAが実質的に無視し得る高効率動作が可能な 光ファイバ増幅器を提供するととにある。

# [0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような目 的を達成するために、請求項1に記載の発明は、増幅媒 り信号光を増幅する光ファイバ増幅器において、前記光 ファイパのコア部分にTmとYbを共添加したことを特 徴とする。

【0014】請求項2に記載の発明は、増幅媒体である 光ファイバにおける励起光の誘導放出現象により信号光 を増幅する光ファイバ増幅器において、前記光ファイバ のコア部分にTmとYbを共添加し、前記光ファイバの\* \*クラッド部分にTb、Ho、Eu、Dy、SmまたはN dのうちの少なくとも1つを添加したことを特徴とす る.

【0015】 請求項3 に記載の発明は、請求項1または 2 に記載の前記励起光の波長は、0.85 μm以上0. 98 μm以下であることを特徴とする。

【0016】請求項4に記載の発明は、請求項1または 3 に記載の前記信号光の波長は、1.6μm以上2.0 μm以下であることを特徴とする。

【0017】請求項5に記載の発明は、請求項2または 3に記載の前記信号光の波長は、1.6μm以上1.7 μπ以下であることを特徴とする。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施形態について詳細に説明する。

【0019】図5に、本発明の一実施形態にかかる励起 過程及び増幅過程を示す。Tmイオンのエネルギー準位 に鑑み、これまでの1.6~1.9μm帯で動作するT DFAの変換効率を劣化させている要因は、励起光の励 起準位間吸収によるものである。従って、本実施形態に おいては、Tmイオンを直接励起するのではなく、最初 に、Yb(イッテルビウム)を共添加した系によりYb を励起し、次に、Yb-Tm間のエネルギー移動により Tmの<sup>3</sup> H。準位にイオンを励起し、無輻射過程を経て <sup>3</sup> F₄ - <sup>3</sup> H。間の反転分布を形成する。

【0020】図6に、本発明の一実施形態にかかる希土 類イオンの吸収及び蛍光スペクトルを示す。この方法で は、励起光の波長は、Ybイオンを有効に励起できると とが必要であり、その波長は0.95μm前後である。 体である光ファイバにおける励起光の誘導放出現象によ 30 一方、Τ m イオンでは 0.95 μ m より短波長域におい ては、励起光ESAがほぼ無視し得る。Ybイオンから Tmイオンへのエネルギー移動は、かなり高効率で起と ることから、結果として1.65μm帯で動作する高効 率なTDFAを実現することができる。

> 【0021】[第1の実施例]第1の実施例では、2種 類の光ファイバ増幅器の利得特性を比較した。以下、増 幅器の構成について記す。

増幅器A・増幅用ファイバーZx系フッ化物ファイバ

コア: Tm2000ppm及びYb5000ppm添加

クラッド: Tb4000ppm添加

コア・クラッド間比屈折率差:3.7%

カットオフ波長: 0. 9 um

・励起光源-0.94μm発振の半導体レーザ

増幅器B・増幅用ファイバーZr系フッ化物ファイバ

· コア: Tm2000ppm添加

クラッド: Tb4000ppm添加

コア・クラッド間比屈折率差:3.7%

カットオフ波長: 0. 9μm

・励起光源-1.2μm発振の半導体レーザ

【0022】図7に、本発明の第1の実施例における光 50 ファイバ増幅器を示す。光ファイバ701a.701b

5

を伝送媒体とする光伝送システムにおいて、光ファイバ 増幅器は、アイソレータ702a, 702bと、信号光 /励起光合分波器703と、増幅用光ファイバ704 と、励起光源705とから構成されている。信号光/励 起光合分波器703は、光ファイバ701aに接続され たアイソレータ702aからの信号光と、励起光源70 5からの励起光とを合波する。信号光/励起光合分波器 703の出力に接続された増幅用光ファイバ704にお いて、誘導放出現象によって増幅された信号光は、アイ ソレータ702bを介して光ファイバ701bに出力さ 10 れる。信号光/励起光合分波器703は、融着延伸型の ファイバカップラを使用した。アイソレータ702a、 702bは、2段型偏波無依存型のものを使用した。 【0023】図8に、本発明の第1の実施例における光 ファイバ増幅器の利得特性を示す。信号光は、発振波長 1. 65 μmのDFB-LDを信号光源として使用し、 光ファイバ増幅器入力レベルを-30dBmとした場合 の利得特性である。図8の横軸は、各々の励起光源70 5を使用した際の励起光量は、信号光/励起光合分波器 703から出射される、言い換えると、増幅用光ファイ 20 最も望ましい。 バ704に入射される励起光量である。図8に示したよ 「うに、励起光量が160mW以上では、増幅器Aの構成 の方が増幅器Bの構成よりも高利得を得ることができ る。

\*【0024】[第2の実施例]第2の実施例では、第1の実施例に示した増幅器Aの構成において、励起光の波長を、0.85、0.88、0.90、0.94、0.95、0.97、0.98μmの7波長で測定した。励起光源705としては、Arレーザ励起チタンサファイア・レーザを使用し、信号光/励起光合分波器703の出力、言い換えると、増幅用光ファイバ704の入力で励起光量を評価した。励起光量は250mWで一定とした。

6

0 【0025】図9に、本発明の第2の実施例における光ファイバ増幅器の利得特性を示す。信号光は、発振波長1.65μmのDFB-LDを信号光源として使用し、光ファイバ増幅器入力レベルを-30dBmとした場合の利得特性である。図9に示したように、励起光の波長として0.85μm以上0.98μm以下の波長を使用することにより正の利得が得られており、有効であることが明らかである。また、励起波長としては、0.88μm以上0.97μm以下の波長であればより望ましく、0.91μm以上0.96μm以下の波長であればり最も望ましい。

【0026】[第3の実施例]第3の実施例では、4種類の光ファイバ増幅器の利得特性を比較した。以下、増幅器の構成について記す。

増幅器C・増幅用ファイバーZr系フッ化物ファイバ

コア: Tm2000ppm及びYb5000ppm添加

クラッド: Tb4000ppm添加

コア・クラッド間比屈折率差:3.7%

カットオフ波長: 0. 9μm

・励起光源-0.94 μ m発振の半導体レーザ

増幅器D・増幅用ファイバーZェ系フッ化物ファイバ

コア: Tm2000ppm添加

クラッド: Tb4000ppm添加

コア・クラッド間比屈折率差:3.7%

カットオフ波長: 0. 9μm

・励起光源-1.2 μm発振の半導体レーザ

増幅器E・増幅用ファイバーZr系フッ化物ファイバ

コア: Tm2000ppm及びYb5000ppm添加

クラッド:希土類未添加

コア・クラッド間比屈折率差:3.7%

カットオフ波長:0.9μm

·励起光源-0.94μm発振の半導体レーザ

増幅器F・増幅用ファイバーZr系フッ化物ファイバ

コア: Tm2000ppm添加

クラッド:希土類未添加

コア・クラッド間比屈折率差:3.7%

カットオフ波長: 0. 9μm

・励起光源-1.2 μm発振の半導体レーザ

【0027】第3の実施例で用いた光ファイバ増幅器の 光合分波器703は、誘電体多層膜とファイバコリメー 構成は、図7に示した構成と同一である。信号光/励起 50 タにより組み立てられたパルクタイプの合分波器を使用 (5)

した。アイソレータ702a, 702bは、2段型偏波 無依存型のものを使用した。各々の励起光源705を使 用した際の励起光量は、信号光/励起光合分波器703 から出射される、言い換えると、増幅用光ファイバ70 4 に入射される励起光量である。 増幅器Cから増幅器F において、励起光量は各々200mWで同一の値とし

【0028】図10に、本発明の第3の実施例における 光ファイバ増幅器の利得特性を示す。図10に示したよ うに、Ybをコアに共添加し、0.94 µmで励起した 10 場合(増幅器CおよびE)の方が、Ybは未添加で、

1. 2 μmで励起した場合(増幅器DおよびF)より高 い利得を得ることができる。

【0029】また、増幅用光ファイバ704のクラッド にTbを添加することにより、増幅のピーク波長を短波 長側にシフトできることが明らかである。なお、クラッ ドには、Tbに限らず、Ho(ホロニウム)、Eu(ユ\* \* ーロピウム)、 Dy (ディスプロシウム)、 Sm (サマ リウム)またはNd(ネオジム)を添加してもよい。 【0030】図10に示した結果から、増幅器Eは、信 号光の波長として、1.6 µmから1.9 µm以下の範 囲でゲインを得ることができるが、励起光量を増やすと

とにより、1.6μmから2.0μmの範囲でゲインを 得ることができる。なお、1. 7 μm以上1. 9 μm以 下の波長であればより望ましく、1.77μm以上1. 84μm以下の波長であれば最も望ましい。

【0031】図10に示した結果から、増幅器Cは、信 号光の波長として、1.6 µmから1.7 µmの範囲で ゲインを得ることができるが、1.63μm以上1.6 9μm以下の波長であればより望ましく、1.64μm 以上1.68μm以下の波長であれば最も望ましい。

【0032】 [第4の実施例] 第4の実施例では、以下 のような光ファイバを増幅媒体として使用した。

増幅器G・増幅用ファイバーテルライト系ファイバ

コア: Tm2000ppm及びYb5000ppm添加

クラッド: Tb4000ppm添加

コア・クラッド間比屈折率差:1.5%

カットオフ波長: 0. 9 μm

・励起光源-0.94 μ m発振の半導体レーザ

増幅器H・増幅用ファイバーテルライト系ファイバ

コア: Tm2000ppm添加

クラッド: Tb4000ppm添加

コア・クラッド間比屈折率差:1.5%

カットオフ波長: 0. 9μm

・励起光源-1.2 μm発振の半導体レーザ

成分とした酸化物系多成分ガラスである。光ファイバ増 幅器の構成は、図7に示した構成と同一である。信号光 /励起光合分波器703から出射される、言い換える と、増幅用光ファイバ704に入射される励起光量で評 価し、増幅器GおよびHの各々の励起光量は、200m Wとした。

【0034】信号光は、発振波長1.65 μmのDFB -LDを信号光源として使用し、光ファイバ増幅器入力 レベルを-30dBmとした場合の利得を評価した結 果、増幅器Gでは利得が25dB、増幅器Hでは利得が 40 15dBであった。テルライト系ファイバよりも、Yb が共添加されたファイバを用いた方が、髙利得が得られ ることがわかる。

【0035】本実施形態においては、増幅用ファイバと して乙ェ系フッ化物と、テルライトガラスとを使用した 場合について述べたが、In系フッ化物ガラスや石英系 ガラスなどのフッ化物ガラスから酸化物ガラスまでの広 いホストガラスの範囲に、本発明を適用することができ ることは言うまでもない。

[0036]

【0033】 CCでテルライトとは、2酸化テルルを主 30 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 Ybを共添加することにより、Tmイオンの励起準位間 吸収を無視し得る励起光の波長を使用することができる ので、Tmイオンの基底準位を最低次・励起準位間での 誘導放出により実現される光ファイバ増幅器の高効率化 が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】Tmイオンのエネルギー準位を示す図である。 【図2】Tmイオンの吸収及び蛍光スペクトルを示す図

である。 【図3】従来の1.65μm帯で増幅動作する光ファイ バ増幅器の利得特性を示す図である。

【図4】従来の光ファイバ増幅器における励起準位間吸 収を説明するための図である。

【図5】本発明の一実施形態にかかる励起過程及び増幅 過程を説明するための図である。

【図6】本発明の一実施形態にかかる希土類イオンの吸 収及び蛍光スペクトルを示す図である。

【図7】本発明の第1の実施例における光ファイバ増幅 器を示した構成図である。

【図8】本発明の第1の実施例における光ファイバ増幅

\*

10

9

器の利得特性を示す図である。

【図9】本発明の第2の実施例における光ファイバ増幅 器の利得特性を示す図である。

【図10】本発明の第3の実施例における光ファイバ増幅器の利得特性を示す図である。

【符号の説明】

\*701a, 701b 光ファイバ

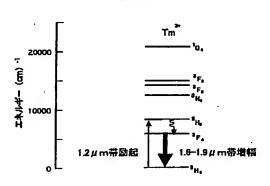
702a, 702b アイソレータ

703 信号光/励起光合分波器

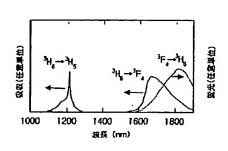
704 増幅用光ファイバ

705 励起光源

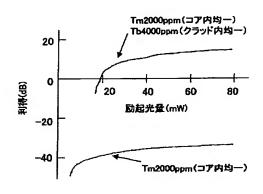
【図1】



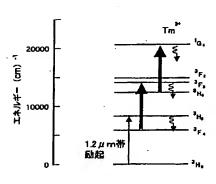
【図2】



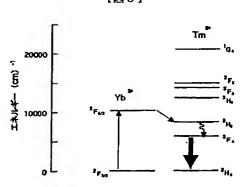
【図3】



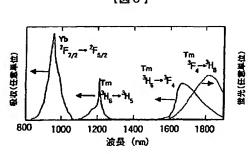
【図4】

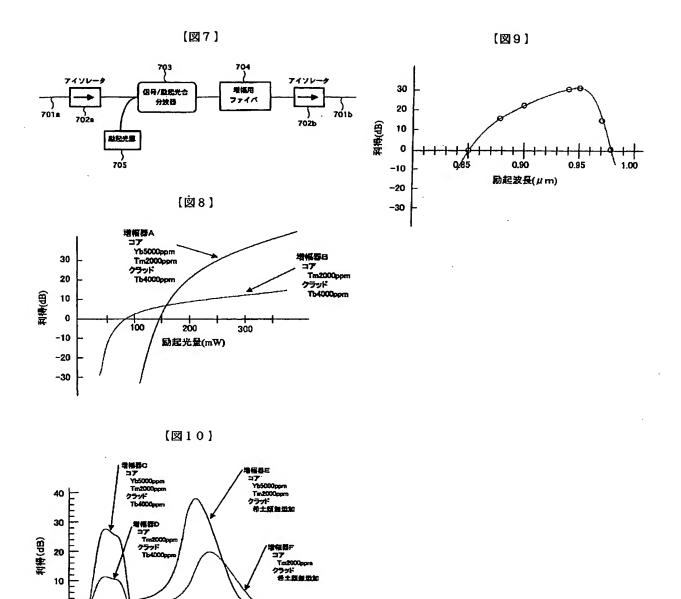


【図5】



【図6】





2.00

フロントページの続き

1.70

1.60

(72)発明者 森 淳 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内

1.80

信号波長(µm)

Fターム(参考) 5F072 AB07 AK06 JJ02 KK30 PP07 PP10 RR01 YY17